トピックス

硬 X 線光電子分光と基礎物性測定により明らかにした 価数の量子臨界現象

久我健太郎

豊田工業大学 〒468-8511 愛知県名古屋市天白区久方 2-12-1

松本洋介

Max Planck Institute for Solid State Research, Heisenbergstrasse 1, 70569 Stuttgart, Germany

大川万里生 東京理科大学 〒162-8601 東京都新宿区神楽坂 1-3

中辻 知

東京大学大学院 〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1

要旨 物質中の価数は通常整数値であるが、価数揺動系と呼ばれる物質群では時間にともないイオンに電子の出入りがあり、イオンが持つ平均価数は非整数となる。基本的に、価数揺動系では磁性が強く抑制されるため通常金属の性質を示す。しかし、価数揺動物質である YbRh₂Si₂ や β-YbAlB₄ において超電導を含む量子臨界現象が近年発見され、この起源解明が未解決問題となっていた。本稿では、新たに我々のグループで開発した価数揺動物質でありながら量子臨界現象を示す α-YbAl_{1-x}Fe_xB₄ を紹介し、硬 X 線光電子分光と電気抵抗、磁化、比熱等の基礎物性測定により量子臨界現象と臨界価数揺らぎの関係を世界で初めて実験的に確立したのでその詳細を説明する。

1. はじめに

物質中の電子には,波動関数の重なりによる隣通しの原 子への移動する効果と電子同士のクーロン斥力による電子 の移動を阻害する効果が働いている。波動関数の重なり効 果が重要な例として重い電子系,電子同士のクーロン斥力 が重要な例としてモット絶縁体,両者が重要な例として銅 酸化物高温超電導体があり,これらの効果が本質的な役割 を果たす物質を強相関電子系と呼ぶ。

最近,我々は局在電子と伝導電子の波動関数の重なり効 果(近藤効果)と電子同士のクーロン斥力がともに重要な 役割を果たす新たな例として,価数の量子相転移とそれに 伴う量子臨界現象を確立した。量子相転移とは絶対零度で 生じる連続的な相転移であり,そこでは相転移前後の状態 が量子力学的に揺らぎ,量子臨界現象と呼ばれる超電導や 非フェルミ液体といった特異な物性を示す。本稿では, SPring-8 BL29XUにて行った硬X線励起内殻光電子分光 測定により示された臨界価数揺らぎの重要性と,100 mK 以下までの極低温にて行った電気抵抗や磁化や比熱測定に より示された量子臨界現象について紹介する。

2. 価数揺動と価数の量子相転移

イオンは元素により複数の価数を持ち価数によって持ち

うる物性が大きく異なるが,通常その価数は整数である。 しかし,希土類化合物において価数揺動系と呼ばれる物質 群では,イオンが持つ局在した4f電子が伝導バンドへ往 来することで価数が時間,空間的に揺らぎ,平均価数が非 整数の値を持つ。この時の4f電子が伝導バンドへ移動す る効果を混成と呼ぶ。一方で,4f電子には近隣の伝導電 子とのクーロン斥力 U_{fe}が働き,U_{fe}には価数が中間価数 状態を取らないようにする効果がある。そのため,4f電 子と伝導電子の間に非常に強いクーロン斥力が働く場合, 価数がある整数から異なる整数へ一次相転移的に変化する ことがあると考えられる。

しかし,実際の物質中ではこれらの効果は競合してお り,価数の一次相転移は混成効果により抑制され,臨界終 点と呼ばれる条件で消失してクロスオーバーと呼ばれる一 次相転移の名残りが現れることがある¹⁾。その際のYb系 化合物における温度-圧力相図を模式的に示したものが Fig. 1Aである。混成効果に対応して磁場や圧力や化学的圧 力を横軸としている。この相図はFig. 1Bに示す液体-気体 の相転移における温度-圧力相図とよく似ており,その性 質も次のように良い対応関係にある。

液体-気体の一次相転移は高温高圧の臨界点にて消失し て超臨界流体を形成し、その臨界点付近では粒子密度が激 しく揺らぎ液体と気体の両方の特徴を持つ。さらに、一次 相転移が消失した後も Widom line と呼ばれる一次相転移



Fig. 1 (A) Phase diagram of Yb-based valence fluctuating systems. Blue region indicates the condition where critical valence fluctuation is strong. (B) Phase diagram of a typical gas-liquid phase transition including supercritical fluid state.

の名残が現れ、臨界点から離れても粒子密度揺らぎが Widom line 周辺に残っている²⁾。一方,価数の一次相転 移の臨界終点周辺では電荷密度が強く揺らいでおり、大き な磁化を持ちながら(磁性イオン,Ybイオンの場合4f 電子が不完全殻の Yb³⁺ 4f¹³) 磁気秩序を示さない(非磁 性イオン,4f電子が閉殻のYb²⁺4f¹⁴)性質を持つ。臨 界終点から離れたクロスオーバー近傍でも、この性質を保 持している。超臨界流体では熱により励起された粒子密度 揺らぎが特異な性質の鍵となっているが、一次相転移の消 失が絶対零度で起こる量子相転移を起こすことは困難であ る。そのため、量子揺らぎがどのような性質を生み出すの かを調べることは難しい。一方で、価数揺動系において は、価数の一次相転移を磁場や圧力や組成により容易に調 整可能であるため、量子相転移を起こす事が現実的に可能 である。さらに、理論的に超電導を含めた量子臨界現象が 予測されており1,3),実験的に価数の量子相転移の詳細を 調べることは重要である。

しかしながら,現実の物質において,4f電子と伝導電 子の間に働くクーロン斥力は弱いため,Ce単体金属⁴⁾や YbInCu₄⁵⁾等の限られた物質でしか価数秩序を伴わない価 数の一次相転移が発見されていない。このような状況の 中,我々は α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄において価数の一次相転移は 観測されなかったものの,価数の一次相転移に関連した臨 界価数揺らぎとそれに伴う量子臨界現象を確立したため, 本稿にて詳細な解説を行う。

3. 実験方法

 α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄ 単結晶は Al のセルフフラックス法に て合成した。その組成比および格子定数は,誘導結合プラ ズマ発光分光法(ICP-AES)や実験室の粉末 X 線回折装 置を用いて決定した。電気抵抗率の測定について,2K ま での低温では温度可変インサート,50 mK までの極低温

では³He-4He 希釈冷凍機を用いて試料を冷却し,4端子 法により交流電流を用いて測定した。磁化率の測定につい て,2Kまでの低温,0.02Tから1Tまでの磁場中では 超伝導量子干渉計(SQUID)を搭載した MPMS(Quantum Design 社)を用いて測定した。さらに極低温におい て0.05 T 以下の磁場中では ³He-4He 希釈冷凍機に装着し た SQUID を用いて25 mK までの測定を行った。その 際、ミューメタルと Nb 超電導シールドを用い、試料空間 内の地球磁場を取り除いた。3T以上の磁場中ではファラ デー法⁶⁾を用いて80 mK までの測定を行った。比熱測定は 緩和法を用い, 0.4 K までは PPMS(Quantum Design 社), 30 mK までは³He-⁴He 希釈冷凍機に装着した手製の比熱 測定セル7)を用いて測定を行った。硬X線光電子分光 (HAXPES) 測定は, SPring-8理研ビームライン BL29XU にて行った^{8,9)}。7.94 keV の硬 X 線により光電子 を励起し、半球型光電子分析器 (Scienta R4000-10 kV) を用いエネルギー分解能250 meV で測定を行った。測定 試料表面について、室温にて10-8 Paの超高真空下で試料 を破断し、20Kに冷やしたうえでその場測定を行った。 フェルミレベルは、試料と電気的に接続した金蒸着薄膜の フェルミ端を測定することで決定した。

α-YbAIB₄ と β-YbAIB₄ と α-YbAI_{1-x}Fe_xB₄の基礎物性

 $\alpha - YbAl_{1-x}Fe_xB_4$ の説明の前に、母物質である α -YbAlB₄ と重要な参照物質である β -YbAlB₄ の紹介をする。 α -YbAlB₄ と β -YbAlB₄ は組成が同じで、その結晶構造は 共に Yb-Al 層と B 層からなる層状構造を持つが, Fig. 2 で示すように隣接する Yb 原子が形成する歪んだ 6 角形の 並びが異なっている¹⁰⁾。10K以上の高温では両者はよく 似た物性を示すものの, 10 K 以下では α-YbAlB₄ は電子 比熱係数 y~130 mJ/mol K² を持ち, 電気抵抗率 p の温度 依存性が極低温にて T^2 ,磁化率 χ ,比熱C/Tが一定とな る通常の重い電子系フェルミ液体の性質を示す¹¹⁾。一方, β -YbAlB₄は、極低温にて ρ , χ , C/Tの温度依存性が $T^{3/2}$, $T^{-1/2}$, log T であり、スピン揺らぎの理論^{12,13)}で説明でき ない新奇な非フェルミ液体の性質を示すとともに80mK にて超電導となる量子臨界現象を示す^{14,15)}。SPring-8に て行った硬 X 線励起内殻光電子分光測定から, Yb イオン の価数が α-YbAlB₄ は2.73, β-YbAlB₄ は2.75の価数揺動 物質であることが分かっており16),価数揺動物質であり ながらβ-YbAlB₄に現れる量子臨界現象の起源の解明が重 要な未解決問題である。

重い電子系フェルミ液体である α -YbAlB₄のAlサイト の一部をFeで置換する(α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄)ことにより, 反強磁性秩序が誘起される¹⁷⁾。参照物質である α -LuAl_{1-x} Fe_xB₄(Lu:非磁性)では磁気秩序を示さない(Fig. 9A) ため,この反強磁性秩序は置換したFeイオンではなく



Fig. 2 (Color online) Crystal structure of (A) α -YbAlB₄, (B) β -YbAlB₄. (C) The perspective view of α -YbAlB₄.



Fig. 3 (Color online) (A) Phase diagram of temperature versus Fe concentration x for α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄ with the contour plot map of the power law exponent $\alpha = \partial \ln (\rho_a(T) - \rho_a(0)) / \partial \ln T$ of the *a* axis resistivity $\rho_a(T)$. T_N denotes the AF Néel point determined by magnetization (closed circles), specific heat (closed squares), and resistivity (closed triangles). (B) Doping dependence of the Yb valence estimated from HAX-PES at 20 K (closed circle, left axis) and doping dependence of the unit cell volume measured by powder x-ray diffraction at several temperatures (closed square, right axis). (Ref. 18)

Yb イオンが担っている。興味深いことに,極低温にて x_c = 0.014では通常の重い電子系フェルミ液体ではなく非フェルミ液体($\rho \sim T^{1.6}$)の振る舞いを示す。電気抵抗率 ρ の温度依存性の冪 α ($\rho \sim T^{\alpha}$)を Fe 置換量と温度の関数としてカラープロットで示したものが Fig. 3A である。 x_c 近傍でのみ極低温まで非フェルミ液体($\alpha < 2$)の振る舞いを示し,典型的な量子臨界点近傍の様相を呈している。四角,三角,丸点は,それぞれ比熱,電気抵抗率,磁化率の測定から決定した反強磁性秩序転移温度である。反強磁性秩序は,x > 0.015にて観測され, x_c 近傍で一次相転移的に消失している。この反強磁性秩序消失について,後で詳しく議論する。



Fig. 4 (Color online) (A) Yb $3d_{5/2}$ core level fitting based on the atomic multiplet calculation of pure α -YbAlB₄. (B) HAX-PES data and the fitting results of α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄. (Ref. 18)

5. 価数のクロスオーバーと臨界価数揺らぎ

磁気秩序が誘起されたという事は磁性イオンである Yb³⁺の割合が増えたという事を示唆し、Fe置換により Yb イオンの価数が増加することが期待される。そこで、 20 K に て Yb 3d_{5/2} 内 殻 光 電 子 分 光 測 定 を 行 い, α-YbAl_{1-x}Fe_xB₄における Yb イオンの価数を決定した。Fig. **4A** に α-YbAlB₄ の Yb 3d_{5/2} 内殻光電子スペクトルとその フィットを示し, Fig. 4B に各 Fe 置換量 x の試料の Yb 3d_{5/2}内殻光電子スペクトルを示す。Yb 3d_{5/2}内殻光電子 スペクトルは、Yb²⁺に起因する1520 eV のシングルピー クと Yb³⁺ に起因する1530 eV 付近の多重項ピークに明確 にスペクトルが分かれており、Yb2+ とYb3+の成分の積 分強度比から Yb イオンの価数を決定可能である。Fig. 3B 左側縦軸に評価した価数のFe置換量x依存性を示す。x を増やすと価数が増加するが、興味深いことに非フェルミ 液体の物性を示すxc=0.014近傍で価数が急激に0.03増加 する(4fホール密度が3%増加することに対応)ことが 分かった。このような Fe 置換量を変えた際の急激な変化 は、単位胞当たりの体積(Fig. 3B 右側縦軸)や低温にお ける磁化率の温度依存性から見積もった有効磁気モーメン ト (Fig. 5) でも確認されており, それぞれ Yb²⁺ と Yb³⁺ が持つイオン半径や磁気モーメントの違いに由来する。こ こで、3%の4fホールの変化は相当量なものであり、価 数の一次相転移を示す Ce 単体金属や YbInCu₄(10から15 %の4f電子あるいはホールの変化4,5))のおよそ20%であ る。

硬X線光電子分光測定から得られた急激であるが連続 的な価数の変化は、価数のクロスオーバーあるいは弱い一 次相転移のいずれかに由来する。後者の場合、連続的な価 数の変化は一次相転移に起因した相分離における体積分率



Fig. 5 (Color online) Temperature dependence of the inverse magnetic susceptibility of α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄ along *c*-axis below 30 K. The inset shows the Fe density dependence of the effective moment and the Weiss temperature estimated by the Curie-Weiss fitting between 5 K and 15 K. (Ref. 18)



Fig. 6 (Color online) Normalized powder X-ray diffraction data at around 400 peak of α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄, where the intensity and the scattering angle 2θ are normalized by those values at the main peak $(2\theta/2\theta_{peak})$. The main peak and the hump at the higher angle correspond to the Cu $K_{\alpha 1}$ and $K_{\alpha 2}$ radiations, respectively. Broken line represents the situation for the case where the phase separation should occur between x = 0.005 and 0.022. (Ref. 18)

の変化に対応し,体積分率が x_c にて増大すると考えられ るが,この可能性は以下の実験的証拠により無いと考えら れる。17 K における粉末 X 線回折のスペクトル幅に広が りが観測されなかった(Fig. 6)。さらに, α -LuAlB4¹⁰と α -LuFeB4¹⁹から見積もった格子の寄与(Yb 4f 電子以外 の寄与,Fig. 7A 破線に対応)を差し引くと,単位胞の体 積変化が x_c 近傍を含んだ全領域で価数に比例し(Fig. 7B),その傾き-12.4 Å³/valence(Fig. 7B 破線)はイオン 半径の違いから期待される-13.3 Å³/valence に近い。こ れらの測定は全て15 K 程度で行われているが, x_c にて25 mK までの測定で相分離に起因する(部分的に価数が大き くなっていることによる)磁気秩序が観測されていないた め,極低温まで相分離は生じていない。

以上の実験結果は,**Fig.3B**(左軸)にて示された価数の 急激な変化が一次相転移に起因する相分離ではなく価数の クロスオーバーであることを示唆する。クロスオーバーは 一次相転移と異なり連続的な変化であるため,*x*c近傍で



Fig. 7 (Color online) (A) Fe density dependence of the lattice constant and volume changes, which are normalized by those for pure α -YbAlB₄. The broken line indicates the lattice contribution of the normalized volume change estimated by using the volume of α -LuAlB₄¹⁰ and α -LuFeB₄¹⁹. (B) Valence change vs. 4*f* (Yb ion) contribution to the volume change ΔV_{4f} . (Ref. 18)



Fig. 8 (Color online) Schematic phase diagram for the valence QC mechanism, which is shown as a function of temperature *T*, magnetic field *B*, and the Fe substitution of *x* in α -YbAl_{1-x} Fe_xB₄. (Ref. 18)

は極低温にて臨界価数揺らぎが発達し量子臨界現象を誘起 させることができる。一方,単位胞当たりの体積は Fig. 3B(右軸)に示すように175 K や273 K でもクロスオーバー に対応した急激な変化が見られる。これは価数のクロス オーバーのエネルギースケールが反強磁性のものよりずっ と高いことを表し,xcにおける量子臨界現象がスピン揺 らぎよりも臨界価数揺らぎが支配的であることを示唆する。

量子臨界現象が臨界価数揺らぎにより誘起されている場合, α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄における相図の模式図は Fig. 8 のようになると考えられる。Fig. 1A に対応させて考えると, 価数の一次相転移は絶対零度, あるいは, 仮想的に負の温度にある。有限温度では, mixed-valent regime (MV)からKondo regime へ変化する価数クロスオーバー面が反り立っている。Kondo regime では, 磁気秩序が x に対して一次相転移的に現れる。

α-YbAl_{0.986}Fe_{0.014}B₄ における 非フェルミ液体

さらに量子臨界現象の性質を調べるため、 x_c における 非フェルミ液体の振る舞いの詳細を紹介する。Fig. 9A、9B はそれぞれの Fe 置換量xの試料に対しての磁化率 $\chi = M/$



Fig. 9 (Color online) Substitution dependence of (A) magnetic susceptibility and (B) 4f electronic contribution to the specific heat divided by T in α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄. In magnetic susceptibility, both zero-field-cooling (ZFC) (open symbols) and field-cooling (FC) (closed symbols) sequences were used. Magnetic susceptibility of α -LuAl_{0.79}Fe_{0.21}B₄ is also shown. (Ref. 18)



Fig. 10 (Color online) (A) Scaling observed for the magnetization M of $x_c = 0.014$ in the range of T < 2 K and B < 50 mT. The solid line is the fitted data for β -YbAlB₄¹⁶). The inset is the temperature dependence of the DC susceptibility M/B for x_c under various fields. Data at x = 0.042 under $B_N = 3.5$ T are also shown (black line). (B) Contour plot of the power law exponent $\alpha = \partial \ln (\rho_a(T) - \rho_a(0)) / \partial \ln T$ of the *a* axis resistivity $\rho_a(T)$ as a function of magnetic field and temperature in x_c . (Ref. 18)

Bと4f電子の比熱を温度Tで割った(C_{4f}/T)ものである。ここで、 C_{4f} について、格子比熱と核Schottky比熱の寄与は差し引いている。Fig.9から明らかなように、 x_c にて $\chi や C_{4f}/T$ が最も発散的になる。 C_{4f}/T の温度依存性は絶対零度に向かい対数的に発散し、準粒子の質量が x_c にて発散していることが分かる。ここで、次に紹介するMaxwellの関係式と磁化のT/Bスケーリングから、100 mK以下で C_{4f} の対数発散が冪発散(β ~0.5)、つまり $C_{4f} \sim T^{-\beta}$ へと変遷すると予想される。

50 mT 以下の弱磁場中では, β-YbAlB₄²⁰⁾と同様に磁化 *M*/*B*の外場変化が有意に *T*/*B*でスケールする。Fig. 10A に示すように, *M*/*B*は *T*<2 K で以下の式で表される単 一のスケール関数 φ (*T*/*B*) で表される。

$$-\frac{dM}{dT} = B^{\alpha - 2}\varphi \,\left(\frac{T}{B}\right) \tag{1}$$

$$\varphi(t) = \Lambda t (A + t^2)^{\alpha/2 - 2} \tag{2}$$

ここで、 $\alpha = 3/2$ であり、充分強い磁場中ではフェルミ液 体の特徴を満たす。この関係式より、磁化率の温度依存性 χ (*T*)は*B*→0の場合 *T*^{-1/2}である。量子臨界点の位置 を表す臨界磁場 *B*_cが有限の場合はスケーリングが *T/B* で はなく*T/(B*-*B*_c)で表されるが、*x*_cの場合はほぼゼロで ある。磁場印加により系統的に非フェルミ液体からフェル ミ液体へと変化する様子は、電気抵抗率の温度依存性の冪 のカラープロット(Fig. 10B)からも見て取れ、ゼロ磁場 にて5K>*T*>1K では温度に対して直線的、1Kよりも 十分低温で*T*^{1.6}だったものが磁場中では*T*²のフェルミ液 体の振る舞いを示す。

 $T^{-1/2}$ の温度依存性と T/Bスケーリングを示す磁化率 や、Tから $T^{1.6}$ に変遷する電気抵抗率は、臨界価数揺ら ぎから理論的に期待される量子臨界現象と一致してい る^{3,21)}。また、磁気秩序がある場合、価数のクロスオー バーにて発達する価数の揺らぎのため磁気秩序転移温度が 一次相転移的に消失することも理論的に予想されてお り²²⁾、実験と理論は良い一致を示している。

7. 磁気的量子臨界点との比較

Fig. 3Aに示すように, $x_c = 0.014 \ge x = 0.0150$ 間で反強 磁性秩序が突然 $T_N > 1.2$ K にて現れる。一次転移的に現 れているとは言え, x_c における量子臨界現象にスピン揺 らぎが影響を与えている可能性は否定できない。この可能 性を検証するため, x = 0.042の試料に対して磁場誘起反強 磁性量子臨界現象の詳細を調べた。一般に,磁場は磁性的 な Kondo regime を安定化させるため, **Fig. 8**の模式図で 示すように価数のクロスオーバー面は磁場により少ない **Fe** 置換量 x の方向に曲がる。したがって,反強磁性相の 充分内側では臨界価数揺らぎの影響を受けていないため, x = 0.042の磁場誘起反強磁性量子臨界現象を調べることで x_c における量子臨界現象との違いを明確にすることが出 来ると期待される。

Fig. 11A は x = 0.042における反強磁性秩序転移温度の磁場依存性と電気抵抗の温度依存性の冪 α のカラープロットである。磁気秩序転移温度は磁場により抑制され, B_N ~3.5 T にて消失するとともに, α ~1.6の非フェルミ液体領域が B_N を中心に扇形に広がっている。その非フェルミ液体領域は, B_N 前後の磁場でフェルミ液体である $\alpha = 2$ へと系統的に変遷しており, B_N が反強磁性量子臨界点であることが分かる。一方,磁化率は Fig. 11B に示すように B_N にて低温に向かって発散的な増加を示さず, x_c にて現れたゼロ磁場量子臨界現象と明らに異なる。 B_N より弱い磁場では,磁気秩序相転移のため,磁化を印加磁場で割っ



Fig. 11 (Color online) (A) Field-temperature phase diagram of the antiferromagnetism and the contour plot of the power law exponent $\alpha = \partial \ln(\rho_a(T) - \rho_a(0))/\partial \ln T$ of the *a* axis resistivity $\rho_a(T)$ in x = 0.042. The Néel points determined by the specific heat C (circles), magnetization M (diamonds), and the resistivity ρ (squares) measurements are shown. (B) T dependence of the DC susceptibility M/B under various fields close to the critical field B_N . Both ZFC (open symbols) and FC (closed symbols) sequences were used. (C) Magnetization curve measured at T=80 mK (right axis) and its field derivative $\partial M/\partial B$ (left axis). The broken line is calculated from scaling Eq. (1) using the parameters determined for the fitting to the data of x_c . Note that the critical field B_c is shifted from zero field to $B_N \sim 3.5$ T. (D) Magnetization divided by the magnetic field M/B at T=80 mK as a function of B. (Ref. 18)

た*M*/*H*の温度依存性に磁場中冷却過程(FC)とゼロ磁 場中冷却過程(ZFC)の間の分岐が現れる。B_Nより強い 磁場では,分岐が消失している。それに対応し,80mK における M/Bの磁場依存性は BN で緩やかなピークを持 ち (Fig. 11D), *dM*/*dB*は*B*_Nより低い磁場の2.9 T でピー クを持つ (Fig. 11C)。一方, x_c の磁化測定から得られたス ケーリング則(式(1))から計算される80mKにおける *dM/dB*の磁場依存性(Fig. 11C 破線)は鋭く大きなピーク を見せ、磁場誘起反強磁性量子臨界点における振る舞いと 際立って異なる。 T^{1.6} の電気抵抗率の温度依存性と発散 的ではない温度依存性の磁化率(Fig. 10A 挿図における黒 線)は、どちらもスピン揺らぎの理論^{12,13)}における反強磁 性揺らぎから予測される振る舞いと一致する。これらの実 験結果から,xcにて現れた価数のクロスオーバーを伴っ たゼロ磁場量子臨界現象は、反強磁性揺らぎの影響ではな く臨界価数揺らぎに起因していると実験的に結論付けられ る。

8. おわりに

本研究結果は、実験的に臨界価数揺らぎと量子臨界現象の関係を確立した初めての例である。第2章で触れたように、臨界価数揺らぎの要因となる価数の一次相転移やクロスオーバーは、4f電子と伝導電子の間に働くクーロン 斥力 U_{fc} を原動力としており、価数の量子臨界現象の理解を深めるうえで U_{fc} の定量評価は大きな役割を果たす。この U_{fc} を実験的に決定する手段として、近年、2p-5d共鳴 HAXPES 測定系が SPring-8 BL09XU にて整備されてきた²³⁾。この測定手法では、希土類化合物に対して L_3 端付近の様々なエネルギーの励起光を用いて 3d 内殻光電子を測定し、2p電子が 5d 軌道へ励起された際に 4f 電子との

間に働くクーロン斥力 U_{fd} の情報について、共鳴増大を通 じて得ることが出来る。ここで、 U_{fd} は U_{fc} の中の一つで あるが、価数の一次相転移やクロスオーバーはオンサイト 以外の影響を殆ど受けないため、 $U_{fc} \sim U_{fd}$ と考えてよい。 α -YbAl_{1-x}Fe_xB₄は言うまでもなく、 β -YbAlB₄との比較 も β -YbAlB₄に現れる超電導や量子臨界現象を理解する上 で重要である。他にも臨界価数揺らぎの可能性が指摘され ている量子臨界物質 YbRh₂Si₂²⁴⁾や価数の一次相転移を示 す YbInCu₄⁵⁾等の情報を得ることで、価数の量子臨界現象 の統一的な理解が深まることが期待される。今後の様々な 価数揺動物質に対する共鳴 HAXPES 測定に期待したい。

謝辞

HAXPES 測定は高田恭孝氏(理化学研究所),松波雅 治氏(分子科学研究所,現,豊田工業大学),江口律子氏 (岡山大学),田口宗孝氏(理化学研究所,現,東芝ナノア ナリシス), Chainani Ashish 氏(理化学研究所,現, National Synchrotron Radiation Research Center), 辛埴氏 (東京大学物性研究所),玉作賢治氏(理化学研究所),西 野吉則氏(北海道大学),矢橋牧名氏(理化学研究所),石 川哲也氏(理化学研究所)との共同研究により行われた。 結晶構造解析は鈴木慎太郎氏(東京大学物性研究所,現, 東京理科大学), 曽根啓太氏 (東京大学物性研究所), 浜根 大輔氏(東京大学物性研究所)との共同研究により行われ た。極低温磁化測定は志村恭通氏(東京大学物性研究所, 現,広島大学),榊原俊郎氏(東京大学物性研究所),柄木 良友氏 (東京大学物性研究所,現,琉球大学),鈴木慎太 郎氏との共同研究により行われた。その他本研究を遂行す る上で、多くの方々と議論し助言を頂いた。この紙面を借 りて感謝を申し上げたい。

参考文献

- S. Watanabe A. Tsuruta, K. Miyake and J. Flouquet: J. Phys. Soc. Jpn. 78, 104706 (2009).
- G. G. Simeoni, T. Bryk, F. A. Gorelli, M. Krisch, G. Ruocco, M. Santoro and T. Scopigno: Nat. Phys. 6, 503 (2010).
- S. Watanabe and K. Miyake: Phys. Rev. Lett. 105, 186403 (2010).
- J. Rohler, D. Wohlleben, J. P. Kappler and G. Krill: Phys. Lett. A 103, 220 (1984).
- 5) H. Sato *et al.*: Phys. Rev. Lett. **93**, 246404 (2004).
- T. Sakakibara, H. Mitamura, T. Tayama and H. Amitsuka: Jpn. J. Appl. Phys. 33, 5067 (1994).
- Y. Matsumoto and S. Nakatsuji: Rev. Sci. Instrum. 89, 033908 (2018).
- T. Ishikawa, K. Tamasaku and M. Yabashi: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 547, 42 (2005).
- Y. Takata *et al.*: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 547, 50 (2005).
- R. T. Macaluso, S. Nakatsuji, K. Kuga, E. L. Thomas, Y. Machida, Y. Maeno, Z. Fisk and J. Y. Chan: Chem. Mater. 19, 1918 (2007).
- 11) Y. Matsumoto, K. Kuga, T. Tomita, Y. Karaki and S. Nakatsuji: Phys. Rev. B 84, 125126 (2011).
- 12) T. Moriya: Spin Fluctuations in Itinerant Electron Mag-

netism (Springer, 1985).

- 13) A. J. Millis: Phys. Rev. B 48, 7183 (1993).
- 14) S. Nakatsuji et al.: Nat. Phys. 4, 603 (2008).
- K. Kuga, Y. Karaki, Y. Matsumoto, Y. Machida and S. Nakatsuji: Phys. Rev. Lett. 101, 137004 (2008).
- 16) M. Okawa et al.: Phys. Rev. Lett. 104, 247201 (2010).
- K. Kuga, G. Morrison, L. Treadwell, J. Y. Chan and S. Nakatsuji: Phys. Rev. B 86, 224413 (2012).
- 18) K. Kuga et al.: Sci. Adv. 4, eaao3547 (2018).
- O. M. Dub, Y. B. Kuz'ma and M. I. David: Poroshk. Metall.
 26, 563 (1987).
- 20) Y. Matsumoto, S. Nakatsuji, K. Kuga, Y. Karaki, N. Horie, Y. Shimura, T. Sakakibara, A. H. Nevidomskyy and P. Coleman: Science **331**, 316 (2011).
- S. Watanabe and K. Miyake: J. Phys. Soc. Jpn. 83, 103708 (2014).
- S. Watanabe and K. Miyake: J. Phys. Soc. Jpn. 79, 033707 (2010).
- 23) E. Ikenaga, A. Yasui, N. Kawamura, M. Mizumaki, S. Tsutsui and K. Mimura: Synchrotron Radiation News 31, 10 (2018).
- 24) O. Trovarelli, C. Geibel, S. Mederle, C. Langhammer, F. M. Grosche, P. Gegenwart, M. Lang, G. Sparn and F. Steglich: Phys. Rev. Lett. 85, 626 (2000).



久我健太郎

豊田工業大学 ポストドクトラル研究員 E-mail: kuga@toyota-ti.ac.jp 専門:光電子分光,試料合成

[略歴] 2011年3月東京大学新領域創成科学研究 科博士後期課程修了。博士(科学)。2011 年4月東京大学物性研究所特任研究員, 2013年11月大阪大学大学院理学研究科特 任研究員,2015年8月理化学研究所放射 光科学研究センター特別研究員,2019年4 月より現職。



松本洋介

[略歴]

マックス・プランク固体科学研究所 量子 物質部門 研究員 E-mail: Y.Matsumoto@fkf.mpg.de 専門:極低温測定,熱力学量測定

2004年3月東京大学大学院理学系研究科 博士後期課程修了。博士(理学)。2004年 4月日本学術振興会特別研究員(東京大学 大学院理学系研究科),2005年4月東京大 学物性研究所リサーチフェロー,2007年3 月同助教,2016年9月より現職。



大川万里生 東京理科大学 理学部第一部 応用物理学

科講師

E-mail: m-okawa@rs.tus.ac.jp 専門:光電子分光 【略歴】

2011年3月東京大学新領域創成科学研究 科博士後期課程修了。博士(科学)。2011 年4月東京理科大学理学部第一部応用物理 学科助教,2016年4月より現職。

中辻 知

東京大学 大学院理学研究科 教授 E-mail: satoru@phys.s.u-tokyo.ac.jp 専門:試料合成,トポロジカル物性物理 学,超伝導,スピントロニクス [略歴]

2001年1月京都大学大学院理学研究科博 土課程修了。博士(理学)。2001年1月日 本学術振興会特別研究員(米国国立高磁場 研究所),2001年4月日本学術振興会海外 特別研究員(米国国立高磁場研究所), 2003年4月京都大学大学院理学研究科講 師,2006年4月東京大学物性研究所助教 授(2007年4月から同准教授),2016年4 月同教授,2019年6月より現職。

著者紹介

Quantum valence criticality probed by HAXPES and physical property measurements

Kentaro KUGA Yosuke MATSUMOTO Mario OKAWA Satoru NAKATSUJI		Toyota Technological Institute, 2–12–1 Hisakata, Tempaku-ku, Nagoya 468–8511, Japan			
		Max Planck Institute for Solid State Research, Heisenbergstrasse 1, 70569 Stuttgart, Germany Tokyo University of Science, 1–3 Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo 162– 8601, Japan The University of Tokyo, 7–3–1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113–0033, Japan			
			Abstract	Valence is usually integer in materials. However, in so-called valence fluctuating systems, the ion will have non-integer average valence due to the frequent charge transfer in ions. Basically, the valence fluctuating systems show normal metal properties due to the strong suppression of magnetism. However, recently quantum critical phenomena including superconductivity were discovered in valence fluctuating systems YbRh ₂ Si ₂ and β -YbAlB ₄ . The origins of these interesting phenomena have been open questions. In this article, we will introduce the valence fluctuating and quantum critical material α -YbAl _{1-x} Fe _x B ₄ which is newly discovered by our group, and we will show the first experimental evidence of the relation between a quantum critical phenomena and a critical valence fluctuation probed by HAXPES and physical property measurements, such as	